

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753

ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>E-mail: csc@renesas.com

製品分類	SRAM	発行番号	TN-M62-A133A/J	Rev.	第1版
題名	32Mb 低消費電力 SRAM : R1WV3216RSD 品の世代交代に関するご連絡		情報分類	製品世代切替	
適用製品	32Mb 低消費電力 SRAM : R1WV3216RSD シリーズ	対象ロット等	関連資料	なし	
		'10/7以降出荷分より順次			

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では 32Mb 低消費電力 SRAM : R1WV3216RSD 品の世代切替を以下のスケジュールにて進めさせて頂く予定ですので、主旨ご理解の上、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 敬具

— 記 —

1. 変更内容 : 32Mb 低消費電力 SRAM : R1WV3216RSD 品 [52pin uTSOP(II)] の世代交代

32Mb (x8/x16) 3V uTSOP 品 : R1WV3216R シリーズ から R1LV3216R シリーズへ

2. 世代交代の概要 : 16MbSRAM 2チップを搭載した MCP 構造製品から、32MbSRAM 1チップ搭載のシングルチップ版への世代交代です。MCP 構造品、シングルチップ品ともに、弊社独自の 0.15 μ m ルール Advanced Low Power SRAMテクノロジーによる T F T 負荷型のキャパシタセルを用いており、ウエハプロセス上変更点はございません。

また、モールド樹脂封止品の外形寸法は従来品と同一、電気的特性スペック面も完全上位互換、信頼性面も同等品質を有しており、そのまま置き換えが可能です。

今後シングルチップ版への集約に伴い、更なる生産性向上を図って参ります。

3. ご承認に関する資料・評価サンプルのご案内 : 貴社にご承認・評価頂く為の資料とサンプルはすでに準備完了しておりますので、弊社担当営業までご要求願います。

4. 切替え時期 : **2010年7月出荷分より開始**

順次 世代交代品に切り換えていく予定です。在庫の兼ね合いにより従来製品 (R1WV3216RSD シリーズ) と並行納入されることがありますので、併せてご了承のほどお願い致します。

5. 世代交代製品の推奨型名 :

1) 現行型名:R1WV3216RSD-7SR ⇒ 推奨型名:R1LV3216RSD-7SR

2) 現行型名:R1WV3216RSD-7SI ⇒ 推奨型名:R1LV3216RSD-7SI

(注) 上記 70ns 品に加え、今回新たに 55ns 品ラインアップを追加しましたので、貴社新規開発案件での採用ご検討の程よろしくお願い申し上げます。

以上、ご高覧の程よろしくお願い致します。